MINOR LEAGUE
マイナーリーグ

マイナーリーグ 求人票（求人番号：3870）

【正社員登用あり】化合物半導体の結晶成長・開発／専門経験を活かす技術職（伊丹）

詳細はこちら

三菱電機株式会社　高周波光デバイス製作所

化合物半導体ウエハプロセスのエピタキシャル成長技術開発のお仕事です。

【職務詳細】
三菱電機の最先端デバイス開発を支える、結晶成長エンジニアの募集です。
MOCVD装置等を用いた原子レベルのモノづくりに挑む本ポジションでは、修士以上の専門知識や結晶成長・評価の経験が最大の強みとなります。論理的な思考と探究心を活かし、プロセスの最適化や新規材料開発の最前線で活躍できる環境です。世界シェアを誇る製品の「源」を創り出す手応えを、国内屈指の技術拠点で実感しませんか。
...以下省略（詳しくはwebサイトへ）

求人内容

業種／職種	メーカー／その他 専門職（オフィス系以外）
業務	その他　上記以外の業務
業務の詳細	光通信用途を始めとしたデバイス開発を支える化合物半導体エピタキシャル成長技術開発を担当していただきます。 ■業務内容例 ● InP／GaAs／GaN 系のIII-V 族化合物半導体のエピタキシャル成長 ・MOCVD装置を用いたInP／GaAs／GaN 系のエピタキシャル成長 ・エピ成長条件（温度、圧力、V/III 比、キャリアガス流量）の設定・調整 ・デバイス仕様に応じたエピ構造の実現（量子井戸層、ヘテロ障壁層、ドーピング制御 など） ● 薄膜の評価および解析 ・エピ成長後の膜厚・組成の評価（XRD、SIMS、PL、TEM、SEM など） ...以下省略（詳しくはwebサイトへ）
就業および雇用形態	契約社員／障害者雇用のみ希望
給与	月給 223,600円 ~ 365,500円 ※業務経験・スキルに応じて個別に相談させていただくこと可能 ・給食手当：3750円 ・その他手当 時間外割増金：1時間につき理論賃金時間割額の13割 休日割増金：1時間につき理論賃金時間割額の14割5分 深夜割増金：1時間につき理論賃金時間割額の3割 昇給あり　年1回　6月 賞与あり　年2回　賞与月数 計3.6カ月（前年度実績）
求められる能力・経験	●必須 ・工学系修士以上または同等の専門知識・スキルを有する方 ・化合物半導体（InP, GaAs, GaNなど）の結晶成長・評価経験に関する実務または研究（3年以上） ・MOCVD、MBEなどの結晶成長装置の操作・プロセス設計経験 ・物性物理、量子力学、電磁気学に関する基礎知識 ●歓迎要件 ・光通信デバイス、高周波デバイスなどの開発経験 ・成膜・エッチング・評価など周辺プロセスの知識 ・英語スキル（論文調査、海外メーカーとの技術ディスカッションなど） ...以下省略（詳しくはwebサイトへ）
勤務形態・勤務地	出社： 兵庫県 伊丹市
勤務時間	08:30 ～ 17:00
求人要項公開期間	2026年03月24日 00時00分 ～ 2027年03月31日 23時59分

もっと詳しい情報はQRコード、または右記URLから：https://mlg.kaien-lab.com/search/show/3870